



 	<h2 style="color: red;">FDP053N08B_F102</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDP053N08B_F102</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDP053N08B_F102.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDP053N08B_F102</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	146W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5960pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP053N08B\_F102 ist neu im Original, Suche FDP053N08B\_F102 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP053N08B\_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP053N08B\_F102: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDP054N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3	 <b>FDP058N10</b> FSC FDP058N10 FSC	 <b>FDP060AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB	 <b>FDP050AN06AO</b> FSC FDP050AN06AO FSC
 <b>FDP053N08B-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A TO-220	 <b>FDP050AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB	 <b>FDP050AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB	 <b>FDP054N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3

### heiße Teile

Mehr

 FDP032N08	 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06
 FDP045N10A	 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047AN08AO	 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08AO	 FDP047N10
 FDP047N10	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08AO
 FDP060N08A0	 FDP060N08AO	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A
 FDP083N15A_F102	 FDP085N10A	 FDP085N10A	 FDP085N10A_F102	 FDP090N10
 FDP090N10	 FDP100N10	 FDP100N10	 FDP10AN06A0	 FDP10AN06A0

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited